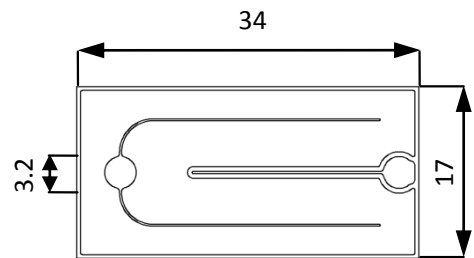


◆ 产品特点:

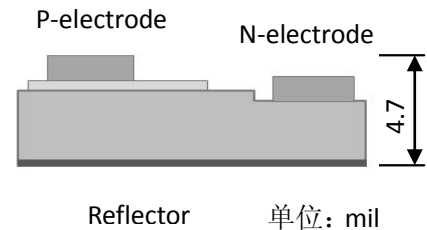
**.*.*.*.*34A

- 高亮度、长寿命
- 户内外应用
- 芯片百分百测试分选
- 波长和光强良好一致性
- DBR/SD 工艺



◆ 物理参数:

芯片尺寸	17mil×34mil(432±25μm×864±25μm)
芯片厚度	4.7mil (120±5μm)
焊盘尺寸	3.2mil (80±10μm) i* diameter
P 电极	金
*电极	金



◆ 光电参数: (Tc=22℃, I_F=120mA)

产品型号	波长范围 (λ _D , *m)		工作电压 (V _F , V)	反向漏电流 (I _R , μA) @V _R =7V	半波宽度 (Δλ, *m)	最大电流 (I _F , mA) DC
	Mi*	Max				
**.*.*.*. B34A	447.5	450	≤3.4	≤1	≤30	200
**.*.*.*. C34A	450	452.5				
**.*.*.*. D34A	452.5	455				
**.*.*.*. E34A	455	457.5				
**.*.*.*. F34A	457.5	460				
**.*.*.*. G34A	460	462.5				

◆ 光强等级: (Tc=22℃, I_F=120mA)

等级	...	185	195	205	215	225	235	...
Po (mW)	...	180-190	190-200	200-210	210-220	220-230	230-240	...

◆ 其他说明:

- 光电参数均系新纳晶光电测试仪器在晶圆条件下的测试数据, 99%符合标称值范围
- 芯片封装工艺最高温度低于 280℃, 持续时间小于 10 秒
- Ga* LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差 ±0.5*m
- 可根据客户要求订做特殊规格的芯片